

2SD1080, 2SD1080(L), 2SD1081, 2SD1081(L)

シリコン NPN エピタキシャル形

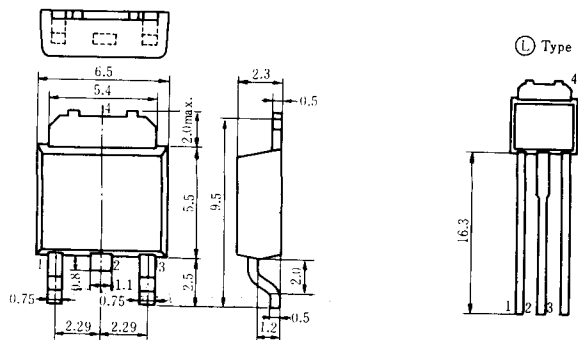
低周波電力増幅用

2SB840/(L), 2SB841/(L) とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SB840/(L) and 2SB841/(L)



(DPAK)

1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
 4. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

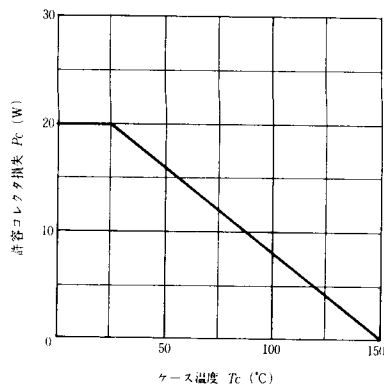
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SD1080/(L)	2SD1081/(L)	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	180	180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	120	160	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	5	V
コレクタ電流	I_C	1.5	1.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	3	3	A
許容コレクタ損失	P_C^*	20	20	W
接合部温度	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	2SD1080/(L)			2SD1081/(L)			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	180	—	—	180	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	120	—	—	160	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=160\text{V}, I_E=0$	—	—	10	—	—	10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=150\text{mA}$	60	—	200	60	—	200	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$	30	—	—	30	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	1	—	—	1	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=150\text{mA}$	—	—	1.5	—	—	1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$	—	140	—	—	140	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	14	—	—	14	—	pF

* 2SD1080/(L), 2SD1081/(L) は h_{FE1} の値により下記のように区分し、現品に表示してあります。

* The 2SD1080/(L) and 2SD1081/(L) are grouped by h_{FE1} as follows.

B	C
60~120	100~200

■ 各特性曲線は 2SD669, 2SD669A 参照。

See characteristic curves of 2SD669 and 2SD669A.